

2SD1295

シリコン NPN エピタキシャルプレーナ形 / Si NPN Epitaxial Planar

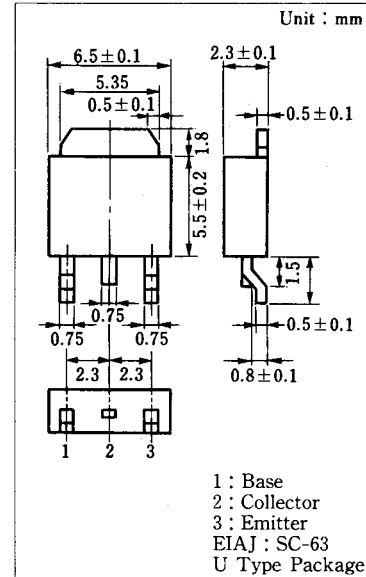
低周波出力増幅用 / AF Output Amplifier
 2SB968 とコンプリメンタリ / Complementary Pair
 with 2SB968

■ 特徴 / Feature

- 2SB968 とコンプリメンタリペアで出力 4 W が得られます。
 4 W output in complementary pair with 2SB968

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

| Item | Symbol | Value | Unit |
|-------------------------------|------------------|------------|------|
| コレクタ・ベース電圧 | V _{CB0} | 50 | V |
| コレクタ・エミッタ電圧 | V _{CEO} | 40 | V |
| エミッタ・ベース電圧 | V _{EBO} | 5 | V |
| せん頭コレクタ電流 | I _{CP} | 3 | A |
| コレクタ電流 | I _C | 1.5 | A |
| コレクタ損失 (T _c =25°C) | P _c | 20 | W |
| 接合部温度 | T _j | 150 | °C |
| 保存温度 | T _{stg} | -55 ~ +150 | °C |



■ 電気的特性 / Electrical Characteristics (T_c=25°C)

| Item | Symbol | Condition | min. | typ. | max. | Unit |
|---------------|----------------------|---|------|------|------|------|
| コレクタしゃ断電流 | I _{CEO} | V _{CE} =10 V, I _B =0 | | | 100 | μA |
| | I _{CBO} | V _{CB} =20 V, I _E =0 | | | 1 | μA |
| エミッタしゃ断電流 | I _{EBO} | V _{EB} =5 V, I _C =0 | | | 10 | μA |
| コレクタ・ベース電圧 | V _{CB0} | I _C =1 mA, I _E =0 | 50 | | | V |
| コレクタ・エミッタ電圧 | V _{CEO} | I _C =2 mA, I _B =0 | 40 | | | V |
| 直流電流増幅率 | h _{FE} *1 | V _{CE} =5 V, I _C =1 A *2 | 50 | | 220 | |
| コレクタ・エミッタ飽和電圧 | V _{CE(sat)} | I _C =1.5 A, I _B =0.15 A *2 | | | 1.0 | V |
| ベース・エミッタ飽和電圧 | V _{BE(sat)} | I _C =2 A, I _B =0.2 A *2 | | | 1.5 | V |
| トランジション周波数 | f _T | V _{CB} =5 V, I _E =-0.5 A *2 | | 150 | | MHz |
| コレクタ出力容量 | C _{ob} | V _{CB} =20 V, I _E =0, f=1 MHz | | 35 | | pF |

*1 h_{FE} ランク分類 / h_{FE} Classifications

| Class | P | Q | R |
|-----------------|----------|----------|-----------|
| h _{FE} | 50 ~ 100 | 80 ~ 160 | 120 ~ 220 |

*2 パルス測定 / Pulse Test